

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成22年4月8日(2010.4.8)

【公表番号】特表2009-524152(P2009-524152A)

【公表日】平成21年6月25日(2009.6.25)

【年通号数】公開・登録公報2009-025

【出願番号】特願2008-551453(P2008-551453)

【国際特許分類】

G 0 6 F 12/16 (2006.01)

H 0 3 M 13/29 (2006.01)

G 1 1 C 16/06 (2006.01)

H 0 3 M 13/19 (2006.01)

H 0 3 M 13/11 (2006.01)

H 0 3 M 13/15 (2006.01)

H 0 3 M 13/25 (2006.01)

【F I】

G 0 6 F 12/16 3 2 0 F

H 0 3 M 13/29

G 1 1 C 17/00 6 3 9 C

H 0 3 M 13/19

H 0 3 M 13/11

H 0 3 M 13/15

H 0 3 M 13/25

【手続補正書】

【提出日】平成22年2月16日(2010.2.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 0】

マルチレベル固体不揮発性メモリにおいて隣接するレベル間の電圧分離が減少すると、従来の固体不揮発性メモリセルに比べて誤り数が増加しうる。従って、マルチレベルセルを有する固体不揮発性メモリを動作させる改善された方法及び技術が望ましい。

なお、本出願に対応する外国の特許出願においては下記の文献が発見または提出されている。

【特許文献1】米国特許第6279133号明細書

【特許文献2】米国特許出願公開第2001/0025358号明細書

【特許文献3】米国特許出願公開第2002/0038440号明細書

【特許文献4】米国特許出願公開第2004/0042294号明細書

【特許文献5】米国特許第7310768号明細書

【特許文献6】米国特許第5469448号明細書

【特許文献7】米国特許第7043162号明細書

【特許文献8】米国特許第725997号明細書

【特許文献9】米国特許第7346829号明細書

【特許文献10】米国特許第7142612号明細書

【特許文献11】米国特許出願公開第2004/0062111号明細書

【特許文献12】米国特許出願公開第2007/0204206号明細書

【特許文献 13】米国特許出願公開第 2004 / 0083334 号明細書

【特許文献 14】米国特許出願公開第 2007 / 0171730 号明細書

【特許文献 15】米国特許第 6715116 号明細書

【特許文献 16】米国特許第 6442726 号明細書

【非特許文献 1】Supplementary European Search Report mailed June 24, 2009, for International Application No. PCT/US2007001623

【非特許文献 2】Examination Report mailed September 28, 2009, for European Patent Application No. 07718319.2

【非特許文献 3】Examination Report mailed September 28, 2009, for European Patent Application No. 07718293.9